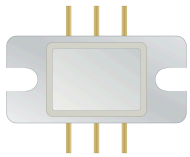
13600–14500 MHz GaN Amplificateur de puissance encapsulé — PSAT ≥ 41 dBm

LCI-PA-13600-14500-PS41MIN · 13600–14500 MHz · GaN Amplificateur de puissance encapsulé.



Valeurs du tableau RF: PSAT ≥ 41 dBm; Gain en puissance ≥ 20 dB; PAE 37 % (typique). Conditions de mesure RF: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW.

CMW010B

Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensions du boîtier: 18.03 × 8.7 mm.

Caractéristiques RF

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	13600	-	14500	MHz
Puissance de sortie saturée	-	41	-	-	dBm
Gain de puissance	-	20	-	-	dB
Rendement en puissance ajoutée	-	32	37	-	%
Planéité du gain en puissance	-	-	0.5	1	dB

Polarisation DC et courants

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tension de drain	-	-	-	-	28	V
Tension de grille	-	-	-	-	-3.05	V

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	-	-	-	32	V
Polarisation de grille minimale	-	-5	-	-	V
Température de stockage	-	-65	-	150	°C
Puissance d’entrée maximale	-	-	-	24	dBm

Dimensions du boîtier

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions du boîtier	18.03 × 8.7	mm
Envergure des broches	14.7	mm

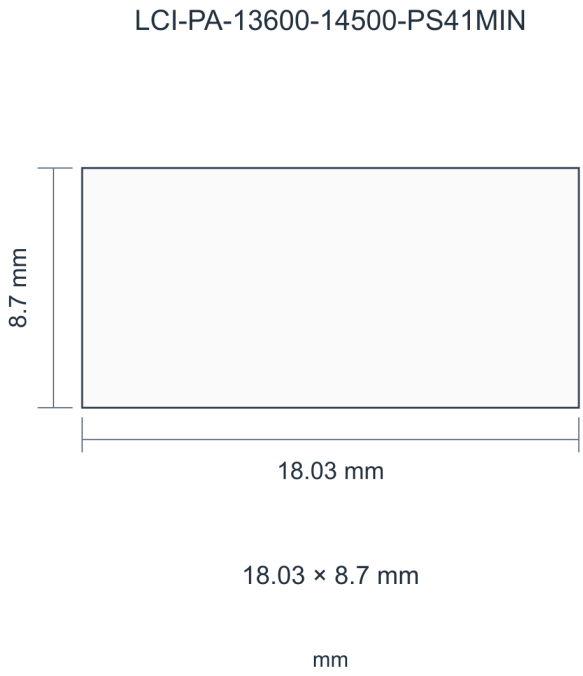
Publication actuelle · 1.6 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.5.

Notes d’intégration

CMW010B Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Plan d’encombrement mécanique

Plan partiel des dimensions confirmées en mm. Pour le montage, reportez-vous au plan d’installation complet.

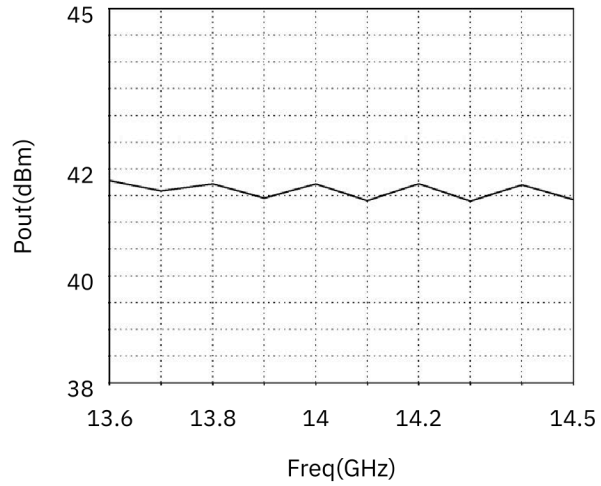


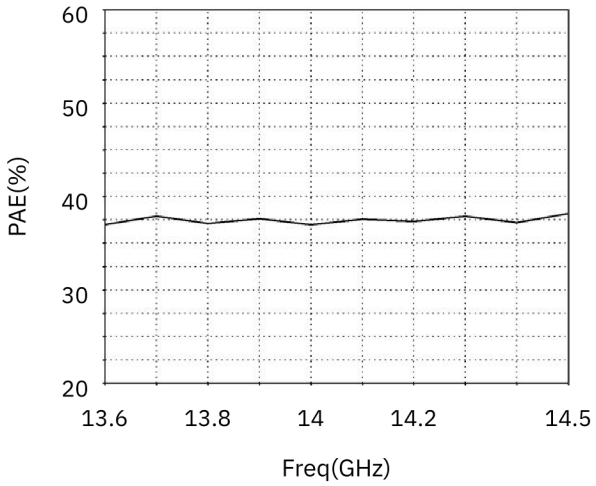
Courbes de performance

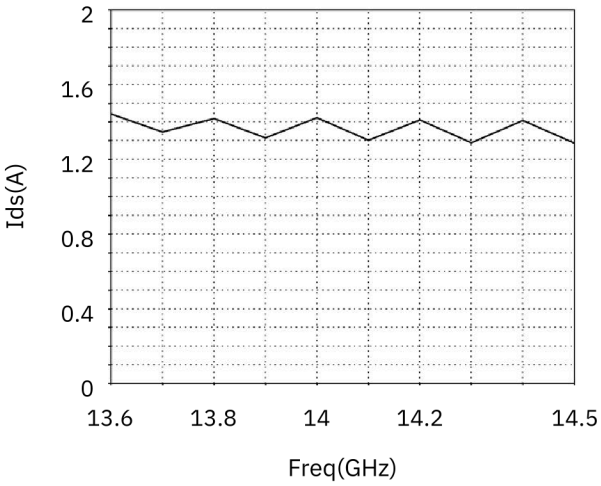
Chaque courbe de performances correspond aux conditions de fonctionnement indiquées sur la figure.

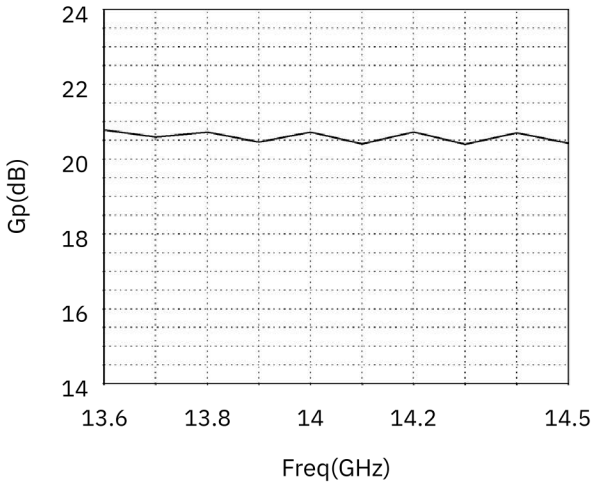
Onde continue (CW) — Puissance de sortie saturée; Rendement en puissance ajoutée; Courant dynamique de drain; Gain de puissance.

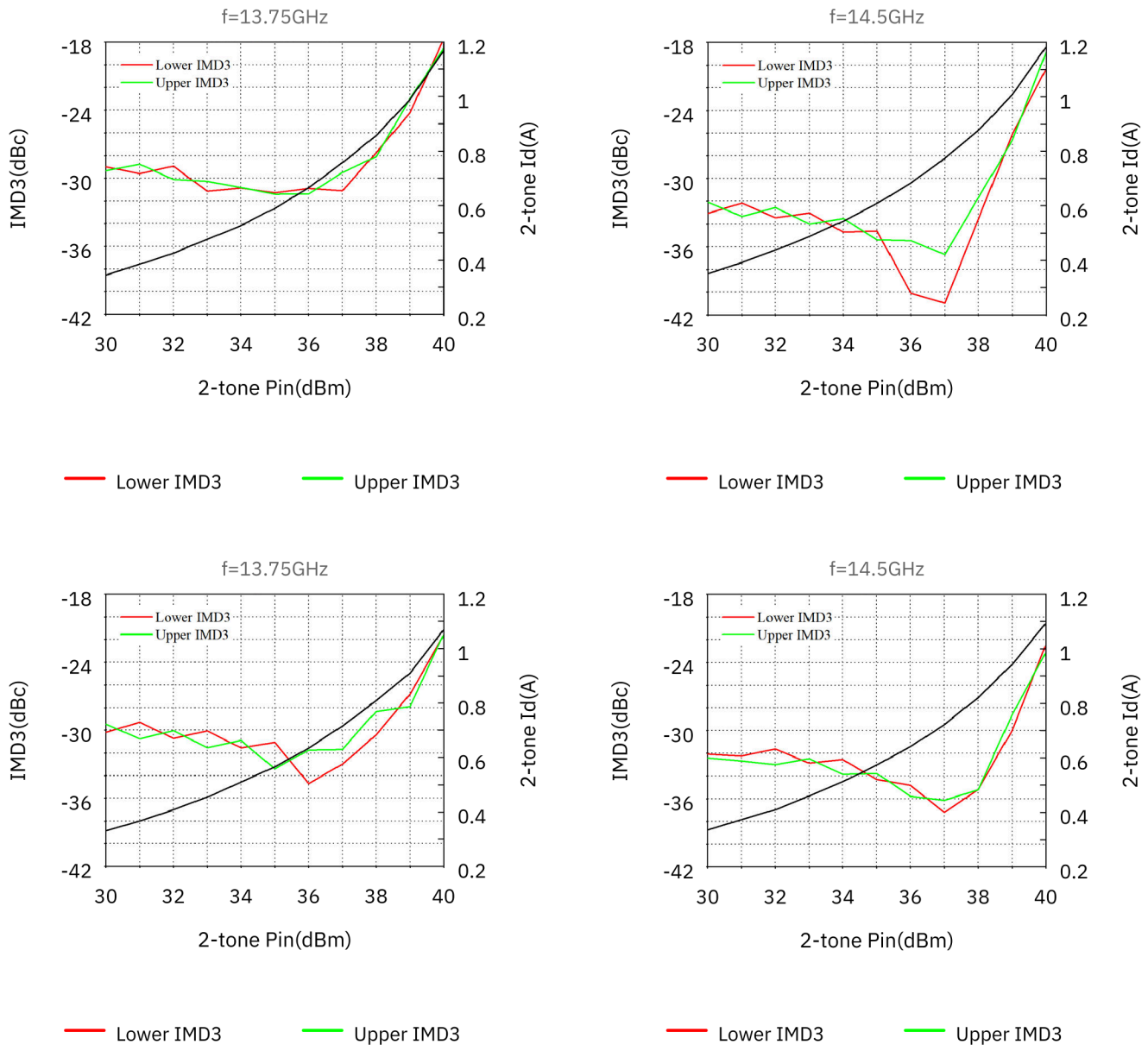
Notes de la figure : TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-3.05V; Pin=21dBm.











IMD3(dBc); Id(A). f = 13.75/14.5 GHz; Δf = 10 MHz; ID = 200 mA; C = 100 nF (1–2), 200 nF (3–4); Pin à deux tons=30...40 dBm.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.